산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 3. 21.(목) 10:30 < 3.21.(목) 석간 > 배포 2024. 3. 20.(수)

고대역폭 메모리(HBM) 등 최첨단 메모리 반도체 생산기지 내년 3월 생산 팹(Fab) 착공 지원나서!

- SK 하이닉스 용인 반도체 일반산단(공정률 35%) 현장방문 및 간담회
- 3월 중「첨단전략산업 특화단지 종합 지원방안」발표 계획

산업통상자원부(이하 산업부) 안덕근 장관은 지난 1.15.(월) 민생토론회에서 발표한 「반도체 메가 클러스터 조성방안」의 핵심지역인 SK 하이닉스 용인 반도체 일반산단(이하 클러스터)을 방문했다.

동 클러스터는 '19년 조성계획 발표 후 인·허가 문제로 개발이 지연되었으나, 이번 정부 출범 이후 당·정·지자체·기업간 상생협약이 체결('22.11)되어 사업이 본 궤도에 올랐다. 1기 팹(Fab) 부지는 약 35%의 공정률을 보이며, 현재 부지 조성 공사가 차질 없이 진행 중이다. '46년까지 120조 원 이상 투자를 통해 총 4기 Fab 구축을 목표로 하고 있고, 내년 3월에는 생산 Fab 1기가 착공될 예정이다. 생산 Fab이 완공 시, '세계 최대 규모의 3층 Fab'이 될 것으로 전망된다.

기업 간담회에서 안덕근 장관은 인프라의 적기 구축, 초격차 기술 확보 및 수출 확대 지원, 반도체 소부장·팹리스 생태계 강화를 약속했다. 산업부는 클러스터 내 인프라 구축을 지원하고자 지난 2월 전력공급 전담반(TF)을 발족했으며, 올해 3월까지 반도체 등 첨단특화단지 지원 전담부서 설치와 「첨단전략산업 특화단지 종합 지원방안」을 마련할 계획이다.

또한 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 증가하는 상황에서, 반도체 기술력 확보와 수출 진작을 위해 AI 반도체 시장 선점을 위한 종합전략을 조속히 마련하고, 반도체 장비 경쟁력 강화방안을 올해 상반기에 마련한다.

나아가 클러스터 내 경쟁력 있는 반도체 생태계 마련을 목표로, 소부장 기술의 양산 검증 테스트베드인 용인 '미니팹 사업'에 대한 예비타당성 조사를 차질 없이 진행하고, 경쟁력 있는 소부장·팹리스 기업들을 대상으로 정책자금을 공급할 예정이다.

안덕근 장관은 "반도체 초격차는 속도에 달린 만큼 우리 기업이 클러스터 속도전에서 뒤처지지 않도록 전 부처가 합심하여 대응하겠다"고 언급하며, "올해 기업들이 반도체 1,200억 달러 수출 목표를 달성할 수 있도록 HBM 등 첨단 반도체의 수출 확대를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

담당 부서 <총괄>	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	전성철 (044-203-4274)
		담당자	사무관	문경준 (044-203-4272)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 1 현장방문 및 간담회 개요

□ **(일시)** 3. 21일(목), 10:30～11:50 (80분)

□ **(장소)** SK 하이닉스 "용인 반도체 클러스터" 일대

* 경기도 용인시 처인구 원삼면 (※ 일반 산업단지)

□ **(참석)** 산업부 장관, SK 하이닉스 사장, SK 에코플랜트 부사장, 용인 일반산단 대표, 산단공 이사장, KIAT 원장, 한전 부사장, 수공 부문장 등

□ **(세부내용)**

시 간		주요 내용	비 고
10:30~10:37	(7′)	■ 인사말	현장사무소
10:37~10:55	(18′)	■ 사업 영상 시청, 주요사업(클러스터 개요, 미니팹 등) 설명	
10:55~11:20	(25′)	■ 기업 간담회(건의사항 청취)	
11:20~11:25	(5′)	■ 이동(현장사무소 → 산단 현장)	
11:25~11:40	(15′)	■ 공사상황 브리핑 및 현장방문	산단 현장
11:40~11:50	(10′)	■ 이동(산단 현장 → 현장사무소)	

참고 2 **SK 용인 일반산단 개요**

□ 단지 개요

○ **(위치/면적)** 용인시 처인구 원삼면 독성·고당·죽능리 일원(약 126만평)

○ **(투자규모)** 총 4기 FAB 건설 예정으로 투자 규모는 약 120조원 이상

○ **(현황)** 부지 조성 및 주요 인프라(전력/용수/도로) 공사 진행 중

○ **(계획)** FAB#1기 착공('25.1Q) → Clean Room Open('27.2Q)

○ **(주요 생산품목)** 메모리 반도체(DRAM, NAND) 생산 예정

□ 클러스터 의의

○ SK하이닉스의 '최대생산 거점'이자 '기술협력 R&D 허브'

- 완공 시, 세계 최대 규모의 3층짜리 FAB이 될 전망

○ 국내 소·부·장 업체와의 협력을 통한 반도체 경쟁력 강화(미니팹 등)

<완공 조감도>



참고 3 **양산형 실증 테스트베드(미니팹) 사업개요**

1. 추진 배경

□ 반도체 소부장 육성 및 소자기업의 기술경쟁력 확보를 위한 **양산 연계형 반도체 소부장 테스트베드** 구축 추진

2. 주요 내용

□ (**사업목표**) 첨단반도체 **소부장 선도기술 진입**을 통한 **공급망 안정화**

□ (**사업기간/총사업비**) **'25~'32년** (8년) / **9,060억원**

* 국고 3,930억원, 지방비 730억원, 민간 4,400억원

□ **(수행주체) 산업통상자원부** (전문기관: 한국산업기술진흥원)

□ **(대상입지)** 경기도 용인시 원삼면 **첨단 반도체 클러스터** 內

* (클러스터) 소부장 특화단지 지정(`21.1), 첨단전략산업 특화단지 지정(`23.7)

□ **(내용) 12인치 웨이퍼** 기반의 **첨단반도체 前공정**용 미니팹

구 분	주요 내용
구축 시설	3,300m^2 규모의 Class 100 이하 클린룸
공간구성	소부장 기업 입주공간 + 반도체 5대 공정별 실증공간
구축 장비	12인치 웨이퍼 기반, 공정 및 계측 장비

□ (**기능**) ①반도체 **소부장 양산 타당성** 실증, ②**Fab 연계 성능 검증**, ③**소부장 R&D** 개발지원, ④반도체 전문인력 **현장 교육시설**